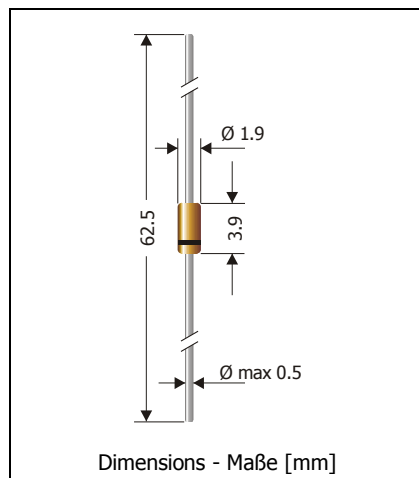


HZ9LA2 (400 mW)
Silicon Planar Zener Diodes for Low Noise Application
Silizium-Planar-Zener-Dioden mit niedrigem Rauschen

Version 2012-06-21



Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung	400 mW
Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung	7.9...8.3 V
Glass case Glasgehäuse	DO-35 (SOD-27)
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g

Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack

**Maximum ratings and Characteristics****Grenz- und Kennwerte**

		HZ9LA2	
Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	400 mW ¹⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+175°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-55...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	375 K/W

Zener voltages see table below – Zener-Spannungen siehe Tabelle unten

Maximum ratings**Grenzwerte**

Type Typ	Zener voltage ²⁾ Zener-Spannung ²⁾ $I_Z = 0.5 \text{ mA}$		Dynamic resistance Diff. Widerstand $r_{Zj} [\Omega]$ at $f = 1 \text{ kHz}$	Temp. Coeff. of Z-voltage ...der Z-Spannung	Reverse volt. Sperrspanng. $I_R = 1 \mu\text{A}$	Z-current ²⁾ Z-Strom $T_A = 25^\circ\text{C}$
	$V_{Z\text{min}} [\text{V}]$	$V_{Z\text{max}} [\text{V}]$	$I_Z = 0.5 \text{ mA}$	$\alpha_{VZ} [10^{-4} / ^\circ\text{C}]$	$V_R [\text{V}]$	$I_{Z\text{max}} [\text{mA}]$
HZ9LA2	7.9	8.3	60	+4...+7	> 6	48

- 1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
- 2 Tested with pulses $t_p=20\text{ms}$ – Gemessen mit Impulsen $t_p=20\text{ms}$